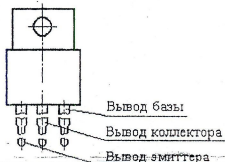


Кремниевые меза-планарные мощные высоковольтные p-n-p транзисторы 2Т81А2, 2Т81В2, 2Т81В2 в пластмассовом корпусе КТ-28-2 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах аппаратуры специального назначения групп исполнения 1.1, 1.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.2.1 исполнения УЖЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 с индивидуальной защитой или общей герметизацией.

Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Сертификат ЦОС "ВОЕНЭЛЕКТРОНЦЕРТ"
Филиал ФГБУ "46 ЦНИИ" Минобороны России
№ СВС.01.431.0491.13

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при $t_{кор} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{кб} = 5\text{ В}$, $I_3 = 5\text{ А}$)	$h_{21э}$	20	
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб} = 100\text{ В}$) 2Т81А2 ($U_{кб} = 80\text{ В}$) 2Т81В2 ($U_{кб} = 60\text{ В}$) 2Т81В2	$I_{кбо}$		1
			1
			1
Граничное напряжение, ($I_k = 100\text{ мА}$, $200\text{ мкс} \leq t_n \leq 300\text{ мкс}$, $Q \geq 100$, $\Delta t_{чзм} \geq 125\text{ мкс}$, $U_{огр} = 95\text{ В} \pm 10\%$), В 2Т81А2 2Т81В2 2Т81В2	$U_{кэо гр}$	80	
		60	
		40	
Пробивное напряжение коллектор-база, ($I_k = 1\text{ мА}$), В 2Т81А2 2Т81В2 2Т81В2	$U_{кбв проб}$	100	
		80	
		80	
		60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, ($I_3 = 5\text{ мА}$) В	$U_{эво проб}$	5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_k = 5\text{ А}$, $I_3 = 0,5\text{ А}$), В	$U_{кэз нас}$	1	
Напряжение насыщения база-эмиттер, ($I_k = 5\text{ А}$, $I_3 = 0,5\text{ А}$), В	$U_{бэз нас}$	1,5	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото 0,0115 г
серебро 0,255 г

1.3 Содержание цветных металлов:

медь – 1,53 г в одном транзисторе.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, тока и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений, $t_{кор} \leq 25^\circ\text{C} - 50000\text{ ч}$.

2.2 Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 50000 ч, а в облегченном режиме – 80000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или во всех местах хранения транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке изготовителя или смонтированных в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальный срок сохраняемости соответствует ГОСТ В 28146-89.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям аА0.339.557 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок – 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки транзисторов – с даты перепроверки. Гарантийная наработка:

25000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
50000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т81А2, 2Т81В2, 2Т81В2 соответствуют техническим условиям аА0.339.557 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от 03.16.89 дата

Место для штампа СКК Место для штампа ВП

Место для штампа "Перепроверка произведена _____" дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа СКК Место для штампа ВП

Цена договорная